

## Обзоры

Гуткин А.А., Аверкиев Н.С.

**Анизотропные ян-теллеровские акцепторы, создаваемые в GaAs элементами первой группы с заполненной d-оболочкой** О б з о р

1299

Герт А.В., Нестоклон М.О., Прокофьев А.А., Яссиевич И.Н.

**Моделирование методом сильной связи кремниевых и германиевых нанокристаллов** О б з о р

1325

## Электронные свойства полупроводников

Мусаев А.М.

**Эффекты локального фотовозбуждения носителей заряда высокой плотности в кремнии**

1341

## Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Немов С.А., Улашкевич Ю.В., Аллаххак А.А.

**Спектры отражения кристаллов р-Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>: Sn в широкой ИК области**

1346

## Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Афонин Н.Н., Логачева В.А.

**Взаимодиффузия и фазообразование в тонкопленочной системе Fe-TiO<sub>2</sub>**

1351

## Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Иванов А.И., Небогатикова Н.А., Куркина И.И., Антонова И.В.

**Механизм резистивных переключений в пленках на основе частично фторированного графена**

1357

Овешников Л.Н., Нехаева Е.И.

**Квантовые поправки к проводимости и аномальный эффект Холла в квантовых ямах InGaAs с пространственно отделенной примесью Mn**

1364

Бондаренко В.Б., Филимонов А.В.

**Критерий сильной локализации на поверхности полупроводника в приближении Томаса-Ферми**

1372

Байрамов Ф.Б., Полоскин Е.Д., Чернев А.Л., Топоров В.В., Дубина М.В., Байрамов Б.Х.

**Измерение времени жизни колебательных состояний молекул ДНК в функционализированных комплексах полупроводниковых квантовых точек**

1376

Зубов Ф.И., Семенова Е.С., Кулькова И.В., Yvind K., Крыжановская Н.В., Максимов М.В., Жуков А.Е.

**Высокая характеристическая температура лазера на квантовых точках InAs/GaAs/InGaAsP с длиной волны излучения около 1.5 мкм, синтезированного на подложке InP**

1382

Матюшкин Л.Б., Мошников В.А.

**Фотолюминесценция нанокристаллов перовскитов CsPbX<sub>3</sub> (X=Cl, Br, I) и твердых растворов на их основе**

1387

Михайлова М.П., Березовец В.А., Парфеньев Р.В., Данилов Л.В., Сафончик М.О., Hospodkova A., Pangrac J., Hulcius E.

**Вертикальный транспорт в гетеропереходах II типа с композитными квантовыми ямами InAs/GaSb/AlSb в сильном магнитном поле**

**Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники**

Чукавин А.И., Валеев Р.Г., Бельтюков А.Н.

**Исследования методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии наноструктур  $ZnS_xSe_{1-x}$ , полученных в матрице пористого оксида алюминия,**

1400

**Физика полупроводниковых приборов**

Викулин И.М., Горбачев В.Э., Курмашев Ш.Д.

**Деградация параметров транзисторных датчиков температуры под действием ионизирующего облучения**

1404

Дикарева Н.В., Звонков Б.Н., Вихрова О.В., Некоркин С.М., Алешкин В.Я., Дубинов А.А.

**Двухчастотный GaAs/InGaP лазерный диод с квантовой ямой GaAsSb**

1410

**Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

Тысченко И.Е., Черков А.Г.

**Диффузионно-контролируемый рост нанокристаллов Ge в пленках  $SiO_2$  в условиях ионного синтеза под высоким давлением**

1414

Кривякин Г.К., Володин В.А., Шкляев А.А., Mortet V., More-Chevalier J., Ashcheulov P., Remes Z., Stuchlikova T.H., Stuchlik J.

**Формирование и исследование p-i-n-структур на основе двухфазного гидрогенизированного кремния со слоем германия в i-области**

1420

Алфимова Д.Л., Лунин Л.С., Лунина М.Л., Арустамян Д.А., Казакова А.Е., Чеботарев С.Н.

**Выращивание и свойства изопараметрических гетероструктур InAlGaPAs/GaAs**

1426

Боднарь И.В., Баругу Т.Г., Касюк Ю.В., Федотова Ю.А.

**Твердые растворы  $(FeIn_2S_4)_x-0.8pt(AgIn_5S_8)_{1-x}$ : кристаллическая структура, ядерные гамма-резонансные спектры и ширина запрещенной зоны**

1434